

	<h2 style="color: red;">SI7956DP-T1-E3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI7956DP-T1-E3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 150V 2.6A PPAK SO-8
	Datenblätter:  SI7956DP-T1-E3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 498 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	


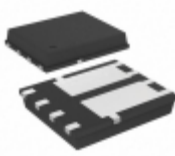
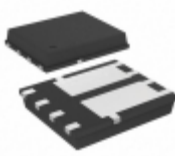
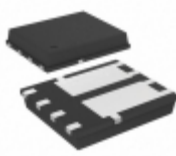
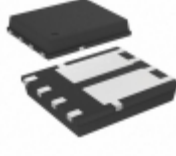
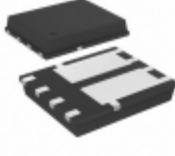
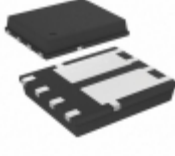
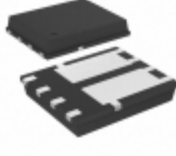
Spezifikationen

Teilenummer	SI7956DP-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 150V 2.6A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	498 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8 Dual
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	105 mOhm @ 4.1A, 10V
Leistung - max	1.4W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8 Dual
Andere Namen	SI7956DP-T1-E3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	26nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 150V 2.6A 1.4W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.6A
Basisteilenummer	SI7956

SI7956DP-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7956DP-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7956DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI7956DP-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7958DP SI SI7958DP SI</p>	 <p>SI7956DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 150V 2.6A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7949DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 60V 3.2A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7958DP-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 40V 7.2A PPAK SO-8</p>
 <p>SI7958DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 40V 7.2A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7956DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 150V 2.6A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7956DP-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 150V 2.6A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7949DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 60V 3.2A PPAK SO-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI7956DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI7956DP-T1-E3 Datenblatt	SI7956DP-T1-E3-Datenblätter	SI7956DP-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7956DP-T1-E3
SI7956DP-T1-E3 Electronic	SI7956DP-T1-E3-Komponenten	SI7956DP-T1-E3-Verteiler	SI7956DP-T1-E3-Bild	SI7956DP-T1-E3-Teil
SI7956DP-T1-E3 Preis	SI7956DP-T1-E3 Hersteller	SI7956DP-T1-E3 Bild	SI7956DP-T1-E3 Aktie	SI7956DP-T1-E3 Inventar
SI7956DP-T1-E3 Neu	SI7956DP-T1-E3 Original	SI7956DP-T1-E3 garantiert	SI7956DP-T1-E3 RFQ	SI7956DP-T1-E3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited